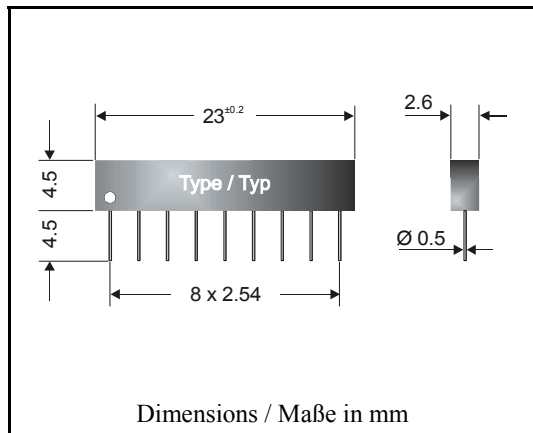
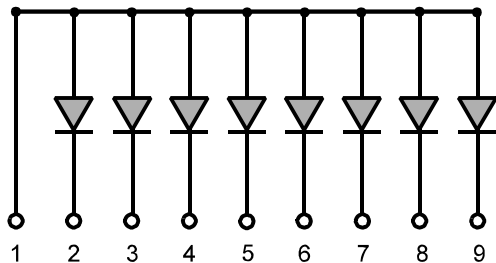


Fast Switching Rectifier Arrays

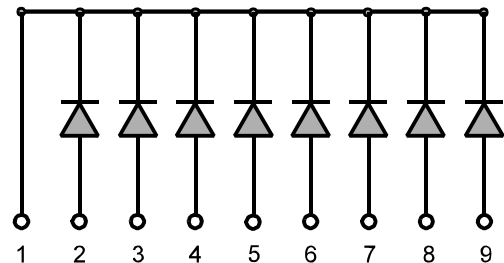
Schnelle Gleichrichter Sätze



Nominal power dissipation 1.2 W
 Nenn-Verlustleistung
 Repetitive peak reverse voltage 100...400 V
 Periodische Spitzensperrspannung
 9 Pin-Plastic case 23 x 2.6 x 4.5 [mm]
 9 Pin-Kunststoffgehäuse
 Weight approx. – Gewicht ca. 0.6 g
 Standard packaging bulk
 Standard Lieferform lose im Karton



"DA 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anoden



"DA 811 K...8110 K": com. cathodes / gem. Kathoden

Maximum ratings

Grenzwerte

| Type Typ | Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] | Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] |
|-------------|--|---|
| DAF 811 A/K | 100 | 120 |
| DAF 814 A/K | 400 | 480 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------------------|
| Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only per diode for simultaneous operation | $T_A = 25^\circ C$ | I_{FAV} 600 mA ¹⁾ |
| | | I_{FAV} 150 mA ¹⁾ |
| Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last, für eine einzelne Diode pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb | $T_U = 25^\circ C$ | I_{FAV} 600 mA ¹⁾ |
| | | I_{FAV} 150 mA ¹⁾ |
| Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwell | $T_A = 25^\circ C$ | I_{FSM} 30 A |

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten

| | | | |
|---|--------------------------|------------------|---------------------|
| Max. power dissipation – Verlustleistung | $T_A = 25^\circ\text{C}$ | P_{tot} | 1.2 W ¹⁾ |
| Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur | | T_j | - 50...+150°C |
| Storage temperature – Lagerungstemperatur | | T_S | - 50...+150°C |

Characteristics

Kennwerte

| | | | | |
|---|--|--|------------------|--|
| Forward voltage Durchlaßspannung | $T_j = 25^\circ\text{C}$ | $I_F = 1\text{ A}$ | V_F | < 1.3 V |
| Leakage current Sperrstrom | $T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$ | $V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$ | I_R I_R | < 10 μA < 90 μA |
| Reverse recovery time Sperrverzug | $I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$ | | t_{rr} | < 350 ns |
| Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft | | | R_{thA} | < 85 K/W ¹⁾ |

¹⁾ Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten